

丸野内 洸 MARUNOUCHI, ko

komarunouchi(at)eis.hokudai.ac.jp



居室：北キャンパス電子科学研究所 3F 03-106

TEL：011-706-9433 / FAX：011-706-9432

研究キーワード：酸フッ化物薄膜

略歴

2023年4月 北海道大学大学院 情報科学院 情報エレクトロニクスコース 入学、現在に至る

2023年3月 北海道大学 工学部 電気電子工学コース 卒業（指導教員：片山 司 准教授）

2019年4月 北海道大学 入学

原著論文

[2] Lizhikun Gong, **Ko Marunouchi**, Akira Chikamatsu, Hiromichi Ohta, and Tsukasa Katayama*, "Large tensile-strained BaTiO₃ films grown on lattice-mismatched La-doped BaSnO₃ bottom electrode", *CrystEngComm* 26, 2765 (2024). (April 24, 2024) (DOI: [10.1039/D4CE00197D](https://doi.org/10.1039/D4CE00197D))

[1] **Ko Marunouchi**, Lizhikun Gong, Hiromichi Ohta, and Tsukasa Katayama*, "High-concentration doping effects of aliovalent Al and Ga on ferroelectric properties of BaTiO₃ Films", *Thin Solid Films* 796, 140339 (2024). (April 16, 2024) (DOI: [10.1016/j.tsf.2024.140339](https://doi.org/10.1016/j.tsf.2024.140339))

学会発表

- [1] **丸野内 洸**, 龔李治坤, 太田裕道, 片山司, “BaTiO₃ 薄膜の強誘電特性への Ga 及び Al 置換効果”, [第 58 回応用物理学会北海道支部/第 19 回日本光学会北海道支部合同学術講演会](#), 室蘭工業大学 (北海道札幌市), 2023.1.7-8.
- [2] **丸野内 洸**, 龔 李治坤, 太田裕道, 片山 司, “BaTiO₃ 薄膜の強誘電特性への Ga 及び Al 置換効果”, [第 70 回 応用物理学会 春季学術講演会](#), 上智大学 四谷キャンパス+オンライン, 2023 年 3 月 15 日-18 日
- [3] **Ko Marunouchi**, Lizhikun Gong, Hiromichi Ohta, and Tsukasa Katayama, “Al and Ga doping effects on ferroelectric and dielectric properties of BaTiO₃ epitaxial films”, [The Mini-Workshop on Functional Materials Science \(Organizers’ meeting\)](#), Sapporo, Japan, December 1-2, 2023. (Poster)
- [4] **丸野内 洸**, 太田裕道, 片山 司, “反応性固相エピタキシャル成長法による Pb₂MO₃F 薄膜(M = Fe, In)の合成”, [第 59 回 応用物理学会北海道支部 / 第 20 回 日本光学会北海道支部 合同学術講演会](#), 北海道大学, 札幌市, 2024.1.6 – 7.
- [5] **丸野内 洸**, 近松 彰, 太田裕道, 片山 司, “反応性固相エピタキシャル成長法による Pb₂MO₃F 薄膜(M = Fe, In)の合成”, [2024 年 第 71 回 応用物理学会春季学術講演会](#), 東京都市大学 世田谷キャンパス, 東京, 2024 年 3 月 22 日-25 日.
- [6] **Ko Marunouchi**, Kodai Niitsu, Akira Chikamatsu, Hiromichi Ohta, Tsukasa Katayama, “Synthesis and properties of Pb₂FeO₃F Thin Films”, [The 25th RIES-HOKUDAI International Symposium 緯\[i\]](#), Clark Memorial Student Center, Hokkaido University, December 10, 2024 (Poster).